


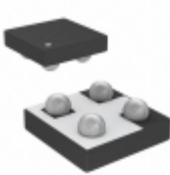





	<h2>SI8413DB-T1-E1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8413DB-T1-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.8A 2X2 4-MFP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8413DB-T1-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 531430 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8413DB-T1-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.8A 2X2 4-MFP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	531430 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.8A (Ta) 1.47W (Ta) Surface Mount 4-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	48 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8413DB-T1-E1TR

SI8413DB-T1-E1 ist neu im Original, Suche SI8413DB-T1-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8413DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8413DB-T1-E1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8415DB-T1</b> VISHAY SI8415DB-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI8410BD-D-IS</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8413DB-T1-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 2X2 4-MFP</p>	 <p><b>SI8410BD-A-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p><b>SI8410DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8410BD-D-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8410DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8413DB-T1-E3</b> VISHAY VISHAY MFP</p>

### heiße Teile

Mehr

SI8400AB-B-ISR	SI8401DB-T1	SI8401DB-T1-E1	SI8401DB-T1-E1	SI8401DB-T1-E3
SI8401DB-T1-E3	SI8402DB-T1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1.
SI8402DB-T1-E3	SI8404DB-T1-E1	SI8404DB-T1-E1	SI8405DB	SI8405DB-T1
SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E3	SI8405DB-T1-E3	SI8409DB-T1
SI8409DB-T1-E1	SI8409DB-T1-E1	SI8410AB	SI8410BB-D-ISR	SI8410BB-I-DS
SI8413DB-T1-E1	SI8415DB-T1	SI8415DB-T1-E1	SI8415DB-T1-E1	SI8417DB-T2-E1
SI8417DB-T2-E1	SI8420BB	SI8420BB-D-IS	SI8421AB-D-ISR	SI8422AB-D-ISR
SI8422BD	SI8424DB-T1-E1	SI8424DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1
SI8429DB-T1-E1	SI8429DB-T1-E1	SI8430-A-IS	SI8430-BIS	SI8430-C-IS
SI8430AB-D-IS	SI8430AB-D-ISR	SI8430BB-C-IS	SI8430BB-D-IS	SI8431-A-IS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited